

## 解説

## 問題 I

- (1) 電荷は半径  $a$  の導体球の表面に分布する. 球対称のため,  $\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E(r)\frac{\mathbf{r}}{r}$ ,  $\mathbf{D}(\mathbf{r}) = D(r)\frac{\mathbf{r}}{r}$ ,  $\mathbf{P}(\mathbf{r}) = P(r)\frac{\mathbf{r}}{r}$  と書ける. 半径  $r$  の同心球の表面  $S$  に対して, 電束密度に関するガウスの法則を適用する.  $S$  内の真電荷を  $q_t(r)$  と書くと

$$\iint_S D_n dS = \iint_S D(r) dS = D(r) \iint_S dS = 4\pi r^2 D(r) = q_t(r)$$

となる.

$$q_t(r) = \begin{cases} 0 & \cdots & r < a \\ Q & \cdots & a < r \end{cases}$$

より

$$D(r) = \begin{cases} 0 & \cdots & r < a \\ \frac{Q}{4\pi r^2} & \cdots & a < r \end{cases}$$

を得る.  $r < b, d < r$  で  $D(r) = \varepsilon_0 E(r)$ ,  $b < r < d$  で  $D(r) = \varepsilon(r) E(r)$  より,

$$E(r) = \begin{cases} 0 & \cdots & r < a \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & \cdots & a < r < b \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon(r)r^2} = \frac{Qr^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 d^4} & \cdots & b < r < d \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & \cdots & d < r \end{cases}$$

を得る.  $D(r) = \varepsilon_0 E(r) + P(r)$  より

$$P(r) = \begin{cases} 0 & \cdots & r < b \\ \frac{Q}{4\pi r^2} \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon(r)}\right) = \frac{Q}{4\pi r^2} \left(1 - \frac{r^4}{\varepsilon d^4}\right) & \cdots & b < r < d \\ 0 & \cdots & d < r \end{cases}$$

を得る.

## (2) 解法 1

中心からの距離が  $r$  の位置での単位体積あたりの電界のエネルギーは  $u_E(r) = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{2} E(r) D(r)$  より, 中心からの距離が  $r \sim r + dr$  の微小部分の体積は  $4\pi r^2 dr$  であるから, この微小部分の電界のエネルギーは  $4\pi r^2 u_E(r) dr$  となる. これより,

$$\begin{aligned} U_E &= \int_0^\infty 4\pi r^2 u_E(r) dr \\ &= \int_a^b 4\pi r^2 \frac{1}{2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \frac{Q}{4\pi r^2} dr + \int_b^d 4\pi r^2 \frac{1}{2} \frac{Qr^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 d^4} \frac{Q}{4\pi r^2} dr + \int_d^\infty 4\pi r^2 \frac{1}{2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \frac{Q}{4\pi r^2} dr \\ &= \int_a^b \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr + \int_b^d \frac{1}{2} \frac{Q^2 r^2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 d^4} dr + \int_d^\infty \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left[ \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{3\varepsilon d^3} (d^3 - b^3) + \frac{1}{d} \right] \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0} \left[ \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{3\varepsilon d} \left( 1 - \frac{b^3}{d^3} \right) + \frac{1}{d} \right] \end{aligned}$$

を得る.

### 解法 2

中心からの距離が  $r$  の位置の電位を  $\phi(r)$  とすると導体球の電位は  $\phi(a)$  となり, 導体球には電荷  $Q$  があるので,

$$\begin{aligned} U_E &= \frac{1}{2} Q \phi(a) = \frac{Q}{2} \int_a^\infty E(r) dr \\ &= \frac{Q}{2} \left[ \int_a^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_b^d \frac{Qr^2}{4\pi\epsilon d^4} dr + \int_d^\infty \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \right] \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left[ \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{3\epsilon d^4} (d^3 - b^3) + \frac{1}{d} \right] \\ &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \left[ \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{3\epsilon d} \left( 1 - \frac{b^3}{d^3} \right) + \frac{1}{d} \right] \end{aligned}$$

を得る.

- (3) 誘電体表面の分極電荷密度  $\omega_P$  は誘電体表面の単位法線ベクトルを  $\mathbf{n}$  とするとき,  $\omega_P = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n}$  で与えられる.  $r = b$  の表面では  $\mathbf{n} = -\mathbf{r}/r$ ,  $r = d$  の表面では  $\mathbf{n} = \mathbf{r}/r$  であるので,

$$\begin{aligned} \omega_P(r=b) &= -P(r=b) = -\frac{Q}{4\pi b^2} \left( 1 - \frac{b^4}{\epsilon d^4} \right), \\ \omega_P(r=d) &= P(r=d) = \frac{Q}{4\pi d^2} \left( 1 - \frac{1}{\epsilon} \right) \end{aligned}$$

を得る. 半径  $r$  の球内の分極電荷  $Q_P(r)$  は, 半径  $r$  の球面を  $S$  として

$$Q_P(r) = - \iint_S P(r) dS = -4\pi r^2 P(r)$$

で与えられる. これより,

$$q_P(r_1, r_2) = Q_P(r_2) - Q_P(r_1) = -4\pi r_2^2 P(r_2) + 4\pi r_1^2 P(r_1)$$

を得る. ここで  $b < r_1 < r_2 < d$  より,

$$q_P(r_1, r_2) = -4\pi r_2^2 \frac{Q}{4\pi r_2^2} \left( 1 - \frac{r_2^4}{\epsilon d^4} \right) + 4\pi r_1^2 \frac{Q}{4\pi r_1^2} \left( 1 - \frac{r_1^4}{\epsilon d^4} \right) = \frac{Q}{\epsilon} \left( \frac{r_2^4}{d^4} - \frac{r_1^4}{d^4} \right)$$

を得る.

### おまけ

誘電体表面以外の全分極電荷は  $q_P(b, d) = \frac{Q}{\epsilon} \left( 1 - \frac{b^4}{d^4} \right)$  となる. 一方表面の分極電荷は,  $4\pi b^2 \omega_P(r=b) + 4\pi d^2 \omega_P(r=d) = -Q \left( 1 - \frac{b^4}{\epsilon d^4} \right) + Q \left( 1 - \frac{1}{\epsilon} \right) = -\frac{Q}{\epsilon} \left( 1 - \frac{b^4}{d^4} \right)$  となり,  $q_P(b, d)$  を打ち消す.

## 問題 II

(1)

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{i}_t + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t},$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},$$

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0,$$

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho_t.$$

(2)

$$-\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{E}_0 = 0,$$

$$-\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{B}_0 = 0,$$

$$\mathbf{B}_0 = -\frac{1}{v} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_0,$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}.$$

(3)

$$\begin{aligned} u(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = \frac{\varepsilon}{2} \mathbf{E}^2 + \frac{1}{2\mu} \mathbf{B}^2 = \frac{\varepsilon}{2} E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) + \frac{1}{2\mu} B_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) \\ &= \frac{\varepsilon}{2} E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) + \frac{1}{2\mu v^2} E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) = \frac{\varepsilon}{2} E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) + \frac{\varepsilon}{2} E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) \\ &= \varepsilon E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S(\mathbf{r}, t) &= \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu v} \mathbf{E} \times (-\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}) \\ &= -\frac{1}{\mu v} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{E}) \hat{\mathbf{k}} - (\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{k}}) \mathbf{E} = -\frac{1}{\mu v} E^2 \hat{\mathbf{k}} = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) \hat{\mathbf{k}}. \end{aligned}$$

$$S(\mathbf{r}, t) = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) \hat{\mathbf{k}} = -v \varepsilon E_0^2 g^2 (\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{r} + vt) \hat{\mathbf{k}} = -v u(\mathbf{r}, t) \hat{\mathbf{k}}.$$

$$\therefore S = -v u \hat{\mathbf{k}}.$$

## 問題 III

- (1) 対称性より  $\mathbf{B}(r, \varphi, z) = B(r) \mathbf{e}_\varphi$ ,  $\mathbf{H}(r, \varphi, z) = H(r) \mathbf{e}_\varphi$ ,  $\mathbf{J}(r, \varphi, z) = J(r) \mathbf{e}_\varphi$  と書ける. 半径  $r$  の同軸円  $C$  に対して, 磁界に関するアンペールの法則を適用する. 真電流は導体を通る電流のみで,  $C$  を貫く真電流を  $I_C(r)$  とすると,

$$\oint_C \mathbf{H}_t ds = \oint_C H(r) ds = H(r) \oint_C ds = 2\pi r H(r) = I_C(r).$$

ここで、導体中を流れる真電流密度は  $\frac{I}{\pi a^2} \mathbf{e}_z$  であるので、 $r < a$  のとき  $I_C(r) = \frac{I}{\pi a^2} \pi r^2 = I \frac{r^2}{a^2}$ ,  $a < r$  のとき  $I_C(r) = I$  である。即ち、

$$I_C(r) = \begin{cases} \frac{Ir^2}{a^2} & \cdots r < a \\ I & \cdots a < r \end{cases}$$

となる。これより、

$$H(r) = \begin{cases} \frac{Ir}{2\pi a^2} & \cdots r < a \\ \frac{I}{2\pi r} & \cdots a < r \end{cases}$$

を得る。 $r < b$ ,  $d < r$  で  $B(r) = \mu_0 H(r)$ ,  $b < r < d$  で  $B(r) = \mu(r) H(r)$  より、

$$B(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} & \cdots r < a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & \cdots a < r < b \\ \frac{\mu(r) I}{2\pi r} = \frac{\bar{\mu} \mu_0 I r^3}{2\pi b^4} & \cdots b < r < d \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & \cdots d < r \end{cases}$$

を得る。 $B(r) = \mu_0 H(r) + J(r)$  より、

$$J(r) = \begin{cases} 0 & \cdots r < b \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left\{ \bar{\mu} \left( \frac{r}{b} \right)^4 - 1 \right\} & \cdots b < r < d \\ 0 & \cdots d < r \end{cases}$$

を得る。

- (2) 磁性体の内側の表面の磁性体内から外へ向かう単位法線ベクトルは  $-\mathbf{e}_r$ , 磁性体の外側の表面の磁性体内から外へ向かう単位法線ベクトルは  $\mathbf{e}_r$  であることから

$$\mathcal{I}_m(b, \varphi, z) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{J}(b, \varphi, z) \times \mathbf{n} = \frac{1}{\mu_0} J(b) \mathbf{e}_\varphi \times (-\mathbf{e}_r) = \frac{1}{\mu_0} J(b) \mathbf{e}_z = \frac{I}{2\pi b} (\bar{\mu} - 1) \mathbf{e}_z,$$

$$\mathcal{I}_m(d, \varphi, z) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{J}(d, \varphi, z) \times \mathbf{n} = \frac{1}{\mu_0} J(d) \mathbf{e}_\varphi \times \mathbf{e}_r = -\frac{1}{\mu_0} J(d) \mathbf{e}_z = -\frac{I}{2\pi d} \left\{ \bar{\mu} \left( \frac{d}{b} \right)^4 - 1 \right\} \mathbf{e}_z.$$

- (3)  $i_m = \frac{1}{\mu_0} \text{rot} \mathbf{J}$  の積分形は、閉曲線  $C$  を縁とする面  $S$  に対し、 $\iint_S i_{mn} dS = \frac{1}{\mu_0} \oint_C J_t ds$  で与えられる。 $C$  を問題の半径  $r_1$  の円とすると、

$$I_m(r_1) = \frac{1}{\mu_0} \oint_C J(r_1) ds = \frac{1}{\mu_0} 2\pi r_1 J(r_1) = \begin{cases} 0 & \cdots r < b \\ I \left\{ \bar{\mu} \left( \frac{r_1}{b} \right)^4 - 1 \right\} & \cdots b < r < d \\ 0 & \cdots d < r \end{cases}$$

を得る. あるいは, 半径  $r_1$  の円に対して  $B$  に関するアンペールの法則の積分形を用いて, 半径  $r_1$  の円を貫く全電流  $I(r_1)$  を求めると,

$$I(r_1) = \frac{1}{\mu_0} \oint_{\text{半径 } r_1 \text{ の円}} B(r_1) ds = \frac{1}{\mu_0} 2\pi r_1 B(r_1) = \begin{cases} \frac{Ir_1^2}{a^2} & \dots \quad r < a \\ I & \dots \quad a < r < b \\ \frac{\mu(r)I}{\mu_0} = \frac{\bar{\mu}Ir_1^4}{b^4} & \dots \quad b < r < d \\ I & \dots \quad d < r \end{cases}$$

を得る. 一方, 半径  $r_1$  の円を貫く真電流  $I_t(r_1)$  は

$$I_t(r) = \begin{cases} \frac{Ir^2}{a^2} & \dots \quad r < a \\ I & \dots \quad a < r \end{cases}$$

これより,

$$I_m(r_1) = I(r_1) - I_t(r_1) = \begin{cases} 0 & \dots \quad r < b \\ I \left\{ \bar{\mu} \left( \frac{r_1}{b} \right)^4 - 1 \right\} & \dots \quad b < r < d \\ 0 & \dots \quad d < r \end{cases}$$

を得る.

おまけ

表面以外の全磁化電流  $I_m$  は,  $I_m = \{I_m(d) - I_m(b)\} e_z = I\bar{\mu} \left\{ \left( \frac{d}{b} \right)^4 - 1 \right\} e_z$ . 一方,  $\mathcal{I}_m(b, \varphi, z)$  と  $\mathcal{I}_m(d, \varphi, z)$  は定ベクトルなので, それぞれ  $\mathcal{I}_m(b, \varphi, z) = \hat{\mathcal{I}}_m(b) e_z$ ,  $\mathcal{I}_m(d, \varphi, z) = \hat{\mathcal{I}}_m(d) e_z$  と書くと, 表面の磁化電流は  $2\pi b \hat{\mathcal{I}}_m(b) e_z + 2\pi d \hat{\mathcal{I}}_m(d) e_z = I\bar{\mu} \left\{ 1 - \left( \frac{d}{b} \right)^4 \right\} e_z$  となり  $I_m$  を打ち消す.

#### 問題 IV

- (1) 対称性より  $E(r, \varphi, z, t) = E(r, t) e_\varphi$ ,  $i(r, \varphi, z, t) = i(r, t) e_\varphi$  と書ける. 半径  $r$  の同軸円周  $C$  に対してファラデーの法則の積分形を適用する.  $C$  を縁とする円を  $S$  と書くと

$$\oint_C E_t ds = - \iint_S \frac{\partial B_{\text{ex},n}}{\partial t} dS.$$

ここで,

$$\oint_C E_t ds = \oint_C E(r, t) ds = E(r, t) \oint_C ds = 2\pi r E(r, t)$$



および

$$\begin{aligned} - \iint_S \frac{\partial B_{\text{ex},n}}{\partial t} dS &= - \iint_S \frac{\partial \{ \mathbf{B}_{\text{ex}}(r, \varphi, z, t) \cdot \mathbf{e}_z \}}{\partial t} dS = - \iint_S \frac{\partial (B_0 + \beta t)}{\partial t} dS \\ &= - \iint_S \beta dS = -\beta \iint_S dS = -\pi r^2 \beta \end{aligned}$$

より,

$$E(r, t) = -\frac{\beta r}{2} = E(r)$$

を得る.  $i(r, \varphi, z, t) = \sigma(r)E(r, \varphi, z, t)$  より,

$$i(r, t) = \sigma(r)E(r) = \sigma_0 \left( \frac{r}{a} \right)^4 \left( -\frac{\beta r}{2} \right) = -\frac{\sigma_0 \beta r^5}{2a^4} = i(r)$$

- (2) 電流も電界も時間に依存していない. 中心軸からの距離が  $r$  の位置での単位体積あたり単位時間あたりジュール熱  $p(r)$  は

$$p(r) = \sigma(r)E^2(r) = \sigma_0 \left( \frac{r}{a} \right)^4 \left( -\frac{\beta r}{2} \right)^2 = \frac{\sigma_0 \beta^2 r^6}{4a^4}.$$

単位長さの導体円柱棒の  $r \sim r + dr$  の微小部分の体積は  $2\pi r dr$  であるので, 単位長さあたり単位時間あたりジュール熱  $P(t)$  は

$$P(t) = \int_0^a p(r) 2\pi r dr = \int_0^a \frac{\sigma_0 \beta^2 r^6}{4a^4} 2\pi r dr = \frac{\sigma_0 \beta^2 \pi}{2a^4} \int_0^a r^7 dr = \frac{\sigma_0 \beta^2 \pi a^8}{2a^4 \cdot 8} = \frac{\pi \sigma_0 \beta^2 a^4}{16} = P.$$

- (3) (1) で求めた電流密度分布は時間変化せず, ソレノイドの重ね合わせと考えられる. 従って  $\mathbf{B}'(r, \varphi, z, t) = B'(r)\mathbf{e}_z$  と書け,  $a < r$  に対し  $B'(r) = 0$  となる.  $R$  を  $a < R$  を満たす長さ,  $h$  を  $0 < h$  を満たす長さとする.  $\varphi = 0$  の面内で,  $A(r, 0, 0)$ ,  $B(r, 0, h)$ ,  $C(R, 0, h)$ ,  $D(R, 0, 0)$  の 4 点を取り, 閉曲線  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$  に対し, アンペールの法則を適用する. この閉曲線を  $C$ ,  $C$  を縁とする長方形  $ABCD$  を  $S$  と書くと

$$\oint_C B'_t ds = \mu_0 \iint_S i_n dS.$$

ここで,

$$\begin{aligned} \oint_C B'_t ds &= \int_{A \rightarrow B} \mathbf{B}' \cdot \mathbf{e}_z ds + \int_{B \rightarrow C} \mathbf{B}' \cdot \mathbf{e}_r ds + \int_{C \rightarrow D} \mathbf{B}' \cdot (-\mathbf{e}_z) ds + \int_{D \rightarrow A} \mathbf{B}' \cdot (-\mathbf{e}_r) ds \\ &= \int_{A \rightarrow B} B'(r) ds = B'(r) \int_{A \rightarrow B} ds = B'(r)h. \end{aligned}$$

一方, 中心軸から距離  $r'$  の位置での電流密度は  $i(r')$ ,  $S$  中で電流密度が存在するのは  $r < r' < a$  の範囲で,  $S$  中で  $r' \sim r' + dr'$  の微小部分の面積は  $h dr'$  なので,

$$\begin{aligned} \mu_0 \iint_S i_n dS &= \mu_0 \iint_S \mathbf{i} \cdot \mathbf{e}_\varphi dS = \mu_0 \int_r^a i(r') h dr' = \mu_0 \int_r^a \left( -\frac{\sigma_0 \beta r'^5}{2a^4} \right) h dr' \\ &= -\mu_0 \frac{\sigma_0 \beta h}{2a^4} \int_r^a r'^5 dr' = -\mu_0 \frac{\sigma_0 \beta h}{2a^4} \frac{1}{6} (a^6 - r^6) = -\frac{\mu_0 \sigma_0 \beta a^2 h}{12} \left( 1 - \frac{r^6}{a^6} \right). \end{aligned}$$

これらより

$$B'(r) = -\frac{\mu_0 \sigma_0 \beta a^2}{12} \left( 1 - \frac{r^6}{a^6} \right).$$